

2SC3415 三重拡散プレーナ形 NPN シリコントランジスタ

高耐圧増幅用/High Voltage Amp.

Triple Diffused Planar NPN Silicon Transistor

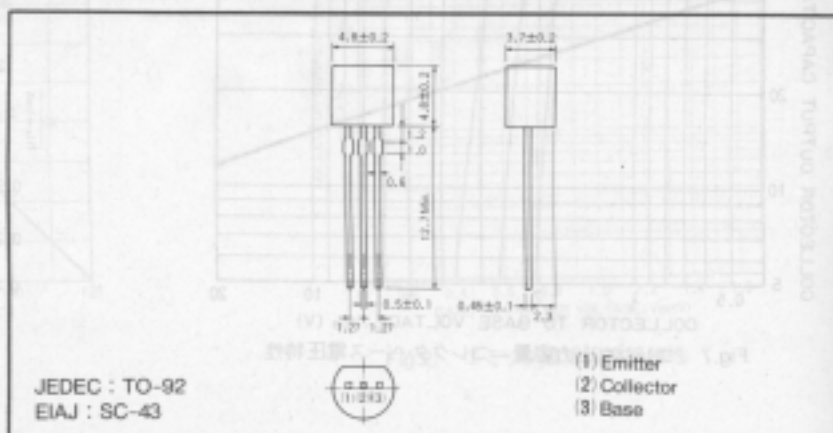
● 特長

- 1) 高耐圧である ($BV_{CEO}=300V$)。
- 2) コレクタ出力容量が小さい。
- 3) カラーテレビのクロマ出力、映像信号増幅に最適。

● Features

- 1) High breakdown voltage:
 $BV_{CEO}=300V$
- 2) Small collector output capacitance.
- 3) Ideal for use in color TV chroma output and video signal amplification.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^{\circ}C$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	300	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	300	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	100	mA
コレクタ損失	P_C	500	mW
接合部温度	T_j	135	$^{\circ}C$
保存温度範囲	T_{stg}	-55~135	$^{\circ}C$

● 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^{\circ}C$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	300	—	—	V	$I_C=100\mu A$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	300	—	—	V	$I_C=50\mu A$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	5	—	—	V	$I_E=50\mu A$
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	—	—	500	nA	$V_{CB}=200V$
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	—	—	500	nA	$V_{EB}=4V$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	2.0	V	$I_C/I_E=50mA/5mA$
直流電流増幅率	h_{FE}	39	—	180	—	$V_{CE}/I_C=10V/10mA$
利得帯域幅積	f_T	50	100	—	MHz	$V_{CE}=30V, I_E=-10mA$
出力容量	C_{ob}	—	3.0	—	pF	$V_{CB}=30V, I_E=0A, f=1MHz$

h_{FE} の値により下表のように分類します。

Item	M	N	P
h_{FE}	39~82	56~120	82~180

● 標準品・準標準品一覧表

(○ : 標準品 ○ : 準標準品)

Type	h_{FE}	基本発注単位(個)	パッケージ			
			バルク	テーピング		
2SC3415	MNP	1 000	1 500	1 500	3 000	3 000